

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成29年1月19日(2017.1.19)

【公開番号】特開2016-92169(P2016-92169A)

【公開日】平成28年5月23日(2016.5.23)

【年通号数】公開・登録公報2016-031

【出願番号】特願2014-224076(P2014-224076)

【国際特許分類】

H 01 L 29/872 (2006.01)

H 01 L 21/20 (2006.01)

H 01 L 29/47 (2006.01)

H 01 L 21/205 (2006.01)

【F I】

H 01 L 29/86 3 0 1 D

H 01 L 21/20

H 01 L 29/48 D

H 01 L 29/48 M

H 01 L 29/86 3 0 1 F

H 01 L 21/205

【手続補正書】

【提出日】平成28年12月1日(2016.12.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 3 8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 3 8】

A1N層(LT(Low Temperature)-A1N層)5は、GaN層4の表面に形成されている。A1N層5は、GaNの結晶性を維持したまま基板の反りを抑制する中間層としての機能を果たす。A1N層5は、たとえばMOCVD法を用いて形成される。A1N層5の成長温度は、GaN層4および6の成膜温度よりも低温とされる。A1N層5の厚さは、0より大きく20nm以下であることが好ましい。A1N層5の厚さは、15nm以下であることがより好ましい。